



ШЕПЕЛЬСЬКИЙ Георгій Анатолійович (16. 11. 1939, с. Краснокутськ, нині с-ще Богодухівського р-ну Харківської обл.) — фізик. Доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1993). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1986). Закінчив Московський

інженерно-фізичний інститут (1967). Працював 1970—2012 в Інституті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1988 — завідувач лабораторії датчиків параметрів технологічних процесів, від 1992 — провідний науковий співробітник. Наукові дослідження: кінетичні рекомбінаційні явища, нерівноважні процеси, механізми дефектоутворення в напівпровідниках.

Основні праці

Physical Properties of A2B6 Semiconductor Crystals After Plastic Deformation at Low Temperature // *Physica Status Solidi* (a). 1988. Vol. 110, № 1; Низкотемпературное движение дислокаций как возможный механизм образования одномерных электронных структур в полупроводниковых кристаллах // *Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики*. 1997. Т. 66, вып. 10; The nanometer scaled defects induces with the dislocation motion in II-VI insulated semiconductors // *Advanced Materials Research*. 2011. Vol. 276; Experimental evidence for the third level (+) of Hg vacancy in Hg_{1-x}CdxTe // *Infrared Physics and Technology*. 2012. Vol. 55, Issue 6; Effect of weak magnetic field on terahertz radiation of hot electrons in n-Ge // *Physica Status Solidi* (b). 2013. Vol. 250 (усі — співавт.).

П. М. Томчук, М. Я. Валах

Бібліографічний опис:

Шепельський Георгій Анатолійович / П. М. Томчук, М. Я. Валах // *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2025. — Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-891002>

2001-2025 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України (докладніше).